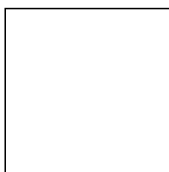


Биполярный транзистор S9013 datasheet

Данный полупроводниковый прибор n-p-n структуры относится к кремневым высокочастотным небольшой мощности до 625 мВт, изготавливается по эпитаксальной технологии в пластиковых корпусах TO-92 и SOT-23. Имеет неплохие технические параметры, особенно хороша линейность коэффициента передачи H_{fe} и высокий номинал коллекторного тока до 500 мА, который он способен пропустить. В электронной технике чаще всего встречается в выходных каскадах усилителей класса В (мощностью до 1 Вт), ключевых схемах и портативных радиостанциях.



Транзистор массово выпускается зарубежом, огромным числом компаний: Micro Commercial Components, Fairchild Semiconductor, Daya Electric Group, Korea Elctronics, Jiangsu Semiconductor, Unclassified Manufacturer и многие другие.

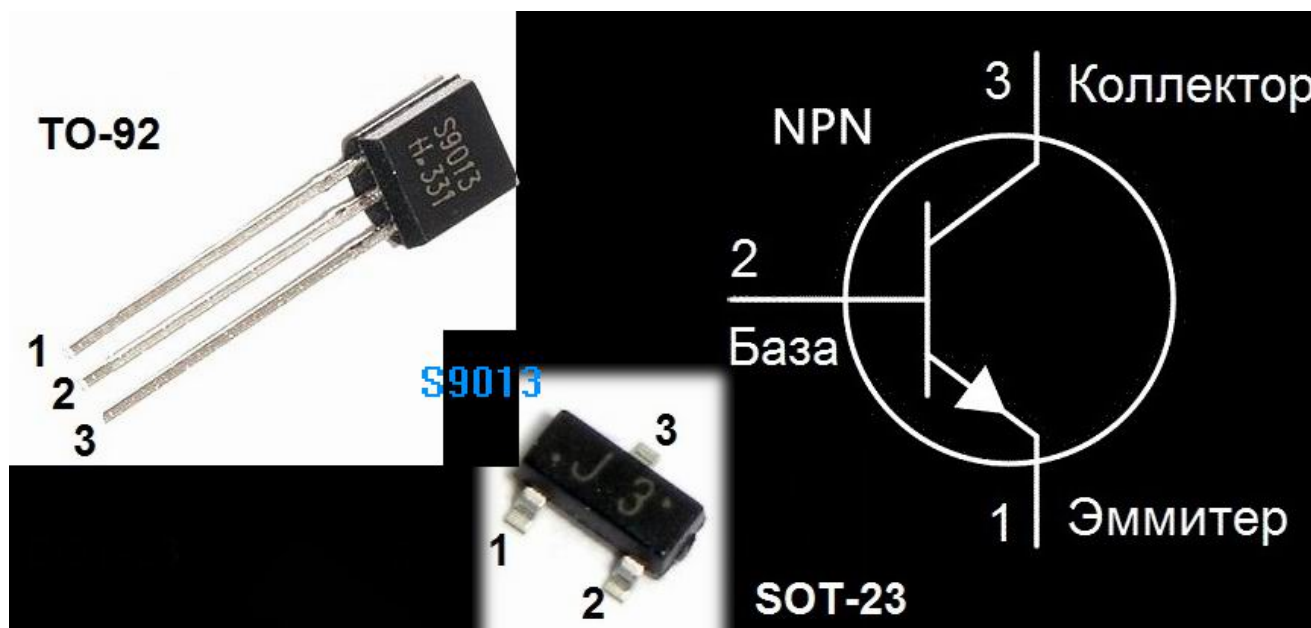


По ссылке выше вы сможете скачать [datasheet на биполярный транзистор S9013](#), а также посмотреть его подробные параметры и технические характеристики, в удобном для просмотра справочной документации, формате PDF.



Цоколевка и распиновка S9013 справочник

Почти все фирмы выпускающие этот компонент, оснащают его классическим пластиковым корпусом TO-92 без радиатора, также он встречается в SMD исполнении SOT-23. Обозначение выводов в обоих упаковках, показано на рисунке ниже:



Наименование, наносится обычно прямо на лицевую часть полностью, для SMD монтажа сокращенным обозначением J3.



Технические параметры и характеристики S9013

Перед нами полупроводниковый прибор, с неплохими техническими параметрами, если верить DataSheet. Рассмотрим их более подробно.

Максимальные значения характеристик S9012 из справочника:

максимальная температура кристалла (ТС) до +150 °C
напряжение между выводами между коллектором и базой 40 В
-/- коллектором и эмиттером 25 В
-/- эмиттером и базой 5 В
коэффициент передачи тока H_{21} от 64 до 400
рассеиваемая мощность 625 мВт;
предельно допустимый постоянный ток коллектора $I_{k\ max} = 500\ mA$

Биполярный транзистор в smd исполнении SOT-23 имеют меньшую допустимую предельную мощность рассеивания — до 300 мВт.

Превышение этих параметров или длительная эксплуатация в максимальных режимах приведет к 100% выходу транзистора из строя.

Основные параметры биполярного транзистора даны в таблице ниже:

Параметры	Режимы измерения	Обозн	min	max	Ед. изм
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер	$I_C = 100\ \mu A, I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$	40		В
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер	$I_C = 1\ mA, I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$	25		В
Пробивное напряжение эмиттер-база	$I_E = 100\ \mu A, I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5		В
Обратный ток коллектора	$V_{CB} = 40\ В, I_E = 0$	I_{CBO}		0,1	мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер	$V_{CE} = 20\ В, I_E = 0$	I_{CEO}		0,1	мкА
Обратный ток эмиттера	$V_{EB} = 5\ В, I_C = 0$	I_{EBO}		0,1	мкА
Статический коэффициент передачи тока	$V_{CE} = 1\ В, I_C = 50\ mA$	h_{FE1}	64	400	
	$V_{CE} = 1\ В, I_C = -500\ mA$	h_{FE2}	40		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$I_C = 500\ mA, I_B = 50\ mA$	$V_{CE(sat)}$		0,6	В
Напряжение насыщения база-эмиттер	$I_C = 500\ mA, I_B = 50\ mA$	$V_{BE(sat)}$		1,2	В
Граничная частота коэффициента передачи тока	$V_{CE} = 6\ В, I_C = 20\ mA, f = 30\ МГц$	f_T	150		нс

В зависимости от параметра коэффициент передачи тока h_{21} Серия S9013 делится на несколько видов: S9013D (64-91); S9013E (78-112); S9013F (96-135); S9013G (112-166); S9013H (144-202); S9013I (190-300), S9013J (300-400)



Аналоги S9013

Импортным аналогом являются полупроводниковые приборы: SS9013, C9013, MMBT9013, KTC9013 (Korea Electronics), но перед их заменой уточняйте параметры в datasheet

Наиболее близкими аналогами являются транзисторы S8050, 2N3904, 2N4401, BC547, BC337, 2N2222



Как проверить S9013 мультиметром



Проверка абсолютно любых биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два п-р перехода, поэтому его можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для п-р-п транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора р-п-р катодами. Устройство считается исправным, если исправны оба перехода.